## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2005年1月13日(13.01.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/004165 A1

(51) 国際特許分類7:

G11C 11/413

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009885

(22) 国際出願日:

2004年7月5日(05.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-192396

2003 年7 月4 日 (04.07.2003)

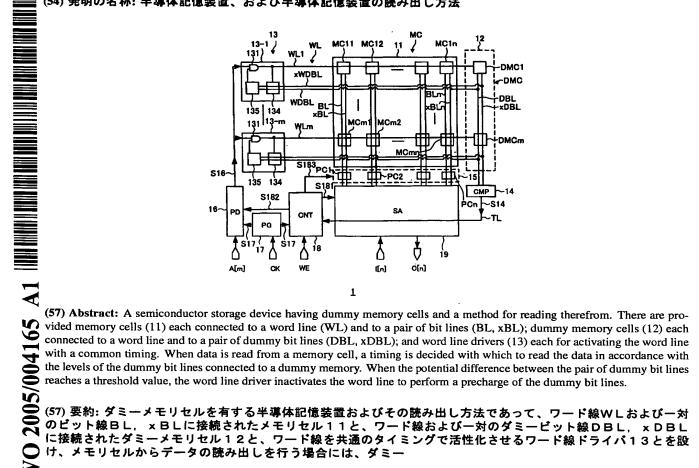
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー 株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]: 〒1410001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 時任 俊作 (TOK-ITO, Shunsaku) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品 川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 佐藤 隆久 (SATOH, Takahisa): 〒1110052 東 京都台東区柳橋2丁目4番2号創進国際特許專務 所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE AND METHOD FOR READING FROM SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出し方法



のピット線BL、xBLに接続されたメモリセル11と、ワード線および一対のダミーピット線DBL、xDBLに接続されたダミーメモリセル12と、ワード線を共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバ13とを設 け、メモリセルからデータの読み出しを行う場合には、ダミー

## 

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- ― 補正書・説明書

補正されたクレーム・説明書の公開日: 2005年3月17日

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。